

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM 100 GB 60 DLC

eupec



Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 70^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$	100	A
	$T_c = 25^\circ\text{C}$	I_C	130	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ms}, T_c = 70^\circ\text{C}$	I_{CRM}	200	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^\circ\text{C}$, Transistor	P_{tot}	445	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	100	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ms}$	I_{FRM}	200	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	1.250	A^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min.}$	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 100\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,95	2,45	V
	$I_C = 100\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	2,20	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 1,5\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance		C_{ies}	-	4,3	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	0,4	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 600\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{CES}	-	1	500	μA
	$V_{CE} = 600\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	1	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Andreas Vetter

date of publication: 2000-04-26

approved by: Michael Hornkamp

revision: 1



Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C= 100A, V_{CC}= 300V$ $V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 25^\circ C$	$t_{d,on}$	-	25	-	ns
	$V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 125^\circ C$		-	26	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C= 100A, V_{CC}= 300V$ $V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 25^\circ C$	t_r	-	10	-	ns
	$V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 125^\circ C$		-	11	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C= 100A, V_{CC}= 300V$ $V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 25^\circ C$	$t_{d,off}$	-	130	-	ns
	$V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 125^\circ C$		-	150	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C= 100A, V_{CC}= 300V$ $V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 25^\circ C$	t_f	-	20	-	ns
	$V_{GE}= \pm 15V, R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 125^\circ C$		-	30	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C= 100A, V_{CC}= 300V, V_{GE}= 15V$ $R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 125^\circ C, L_{\sigma CE}= 15nH$	E_{on}	-	1,0	-	mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C= 100A, V_{CC}= 300V, V_{GE}= 15V$ $R_G= 2,2\Omega, T_{vj}= 125^\circ C, L_{\sigma CE}= 15nH$	E_{off}	-	2,9	-	mJ
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC}= 360V, V_{CEmax}= V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	450	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	40	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	$T_c= 25^\circ C$	R_{CC+EE}	-	1,0	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F= 100A, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25^\circ C$	V_F	-	1,25	1,6	V
	$I_F= 100A, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 125^\circ C$		-	1,20	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F= 100A, -di_F/dt= 4400A/\mu sec$ $V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25^\circ C$	I_{RM}	-	150	-	A
	$V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125^\circ C$		-	180	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F= 100A, -di_F/dt= 4400A/\mu sec$ $V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25^\circ C$	Q_r	-	7,7	-	μC
	$V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125^\circ C$		-	13	-	μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F= 100A, -di_F/dt= 4400A/\mu sec$ $V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 25^\circ C$	E_{rec}	-	-	-	mJ
	$V_R= 300V, V_{GE}= -10V, T_{vj}= 125^\circ C$		-	3,2	-	mJ



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,28	K/W
	Diode / diode, DC		-	-	0,50	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1W/m^2K$ / $\lambda_{grease} = 1W/m^2K$	R_{thCK}	-	0,03	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				Al ₂ O ₃	
Kriechstrecke creepage insulation				15	mm
Luftstrecke clearance				8,5	mm
CTI comperative tracking index				275	
Anzugsdrehmoment für mech. Befestigung mounting torque	Schraube M6 screw M6	M1	-15	5 +15	Nm %
Gewicht weight		G		180	g

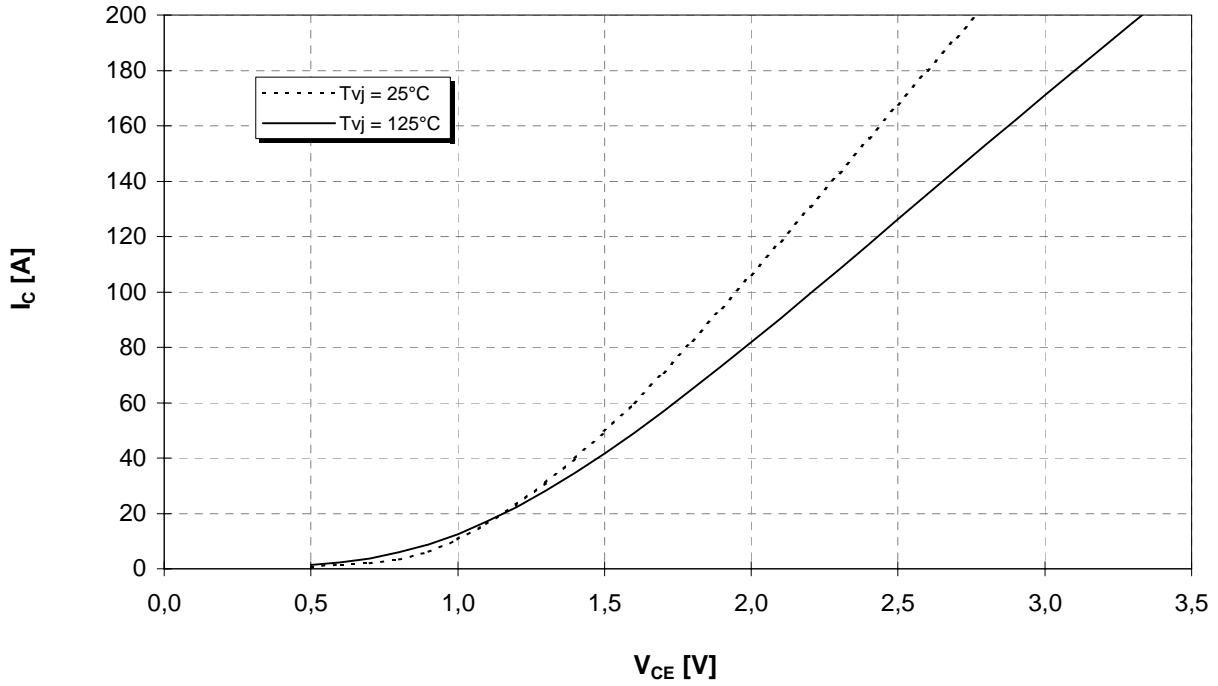
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



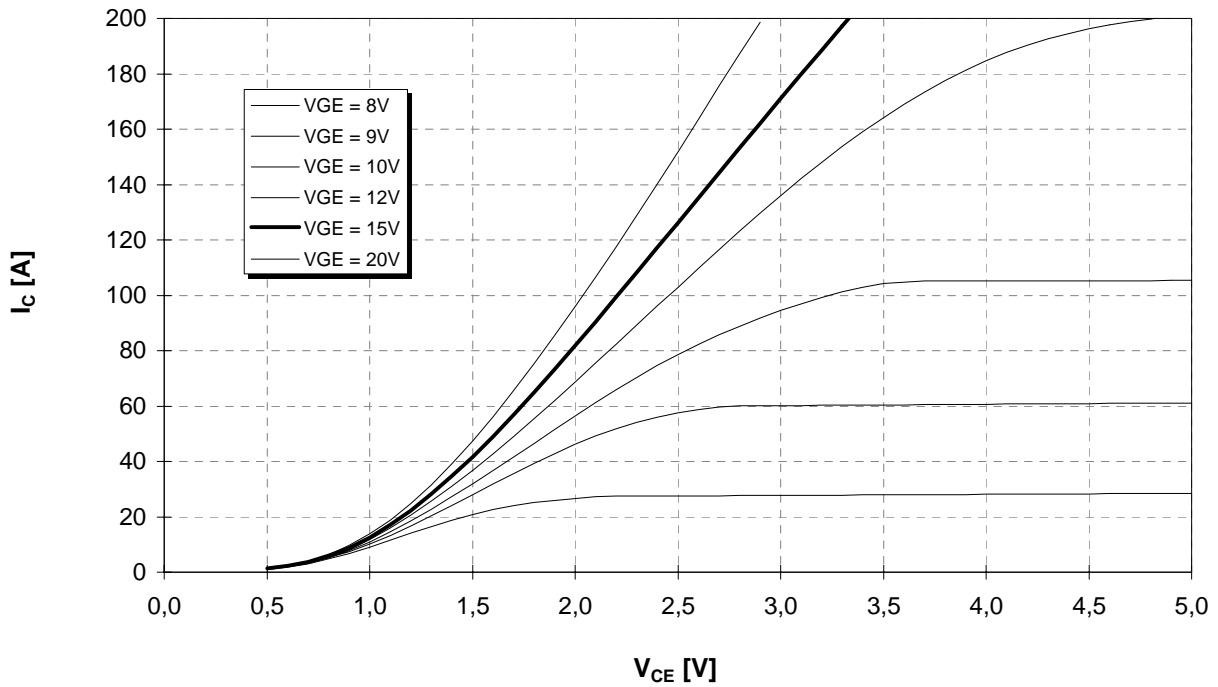
Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

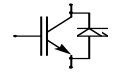
$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

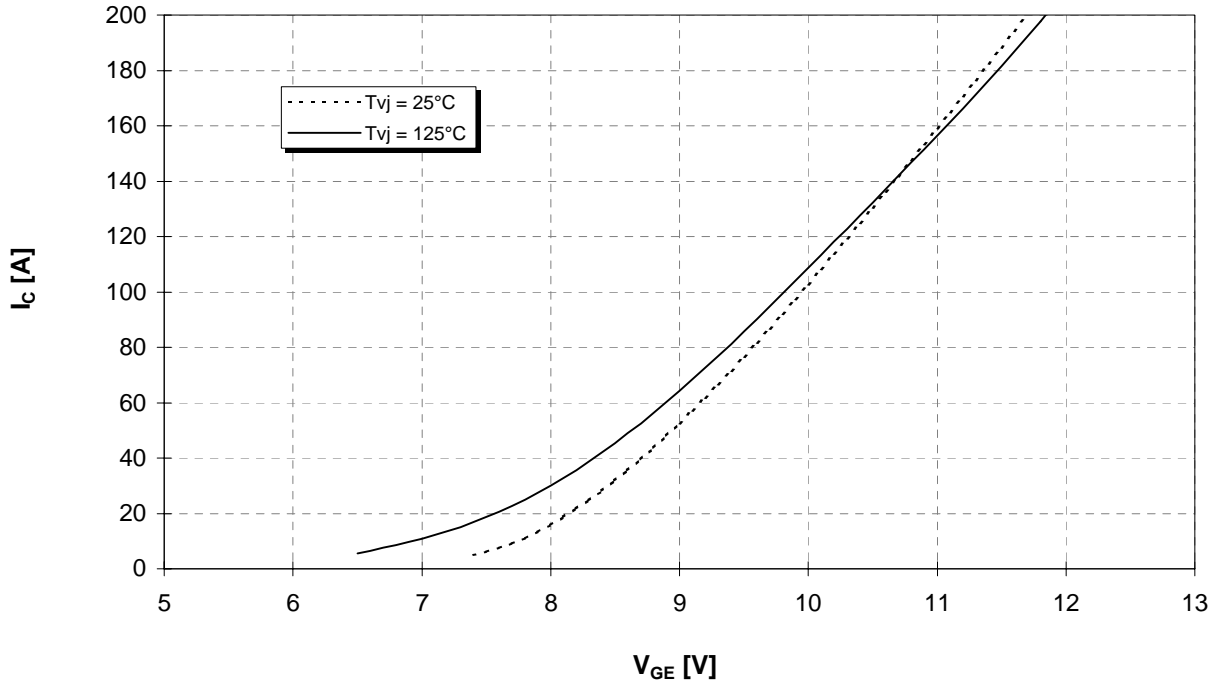
$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$





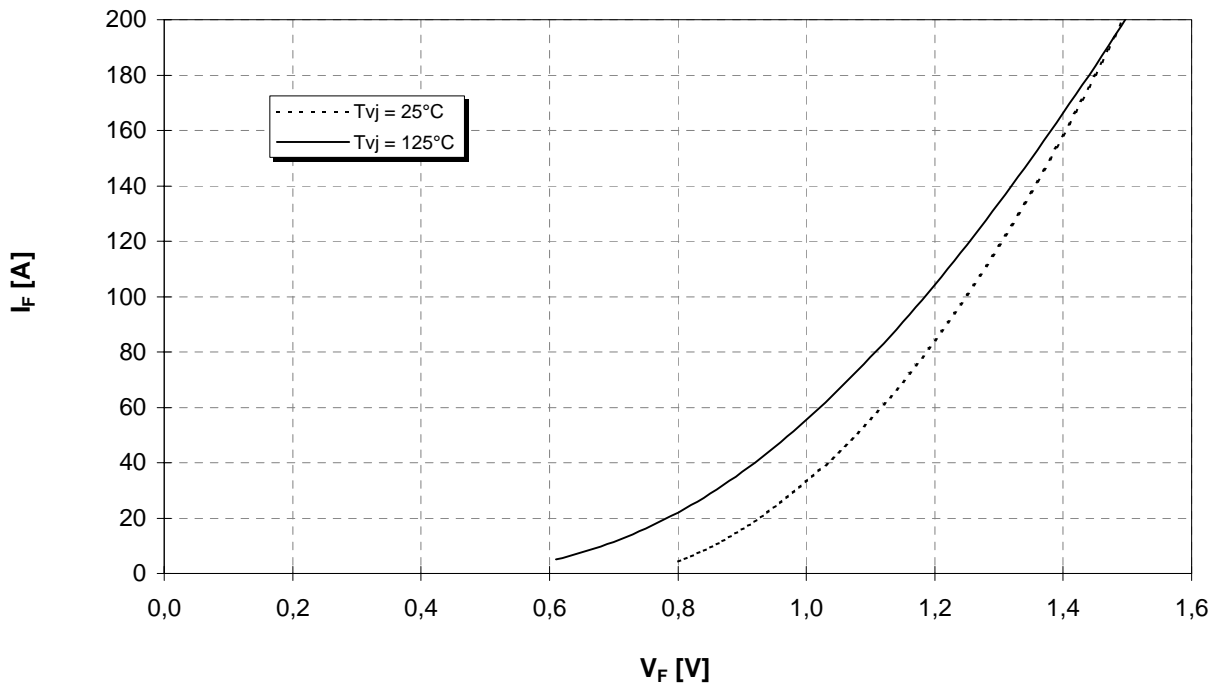
Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

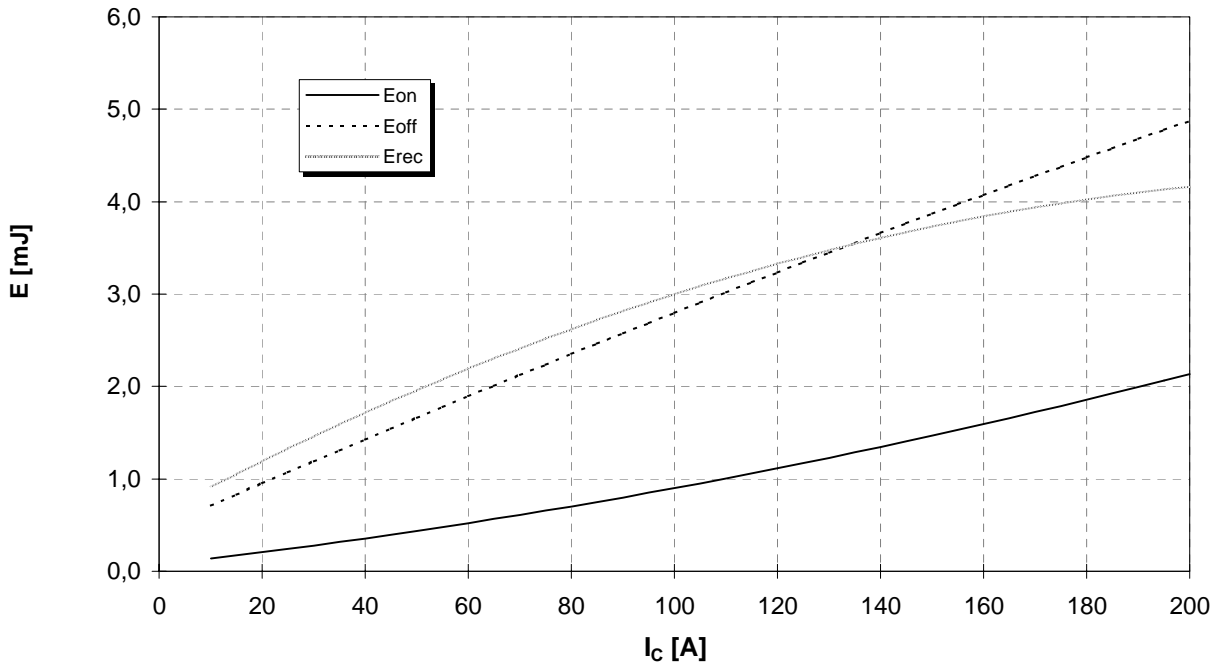




Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$

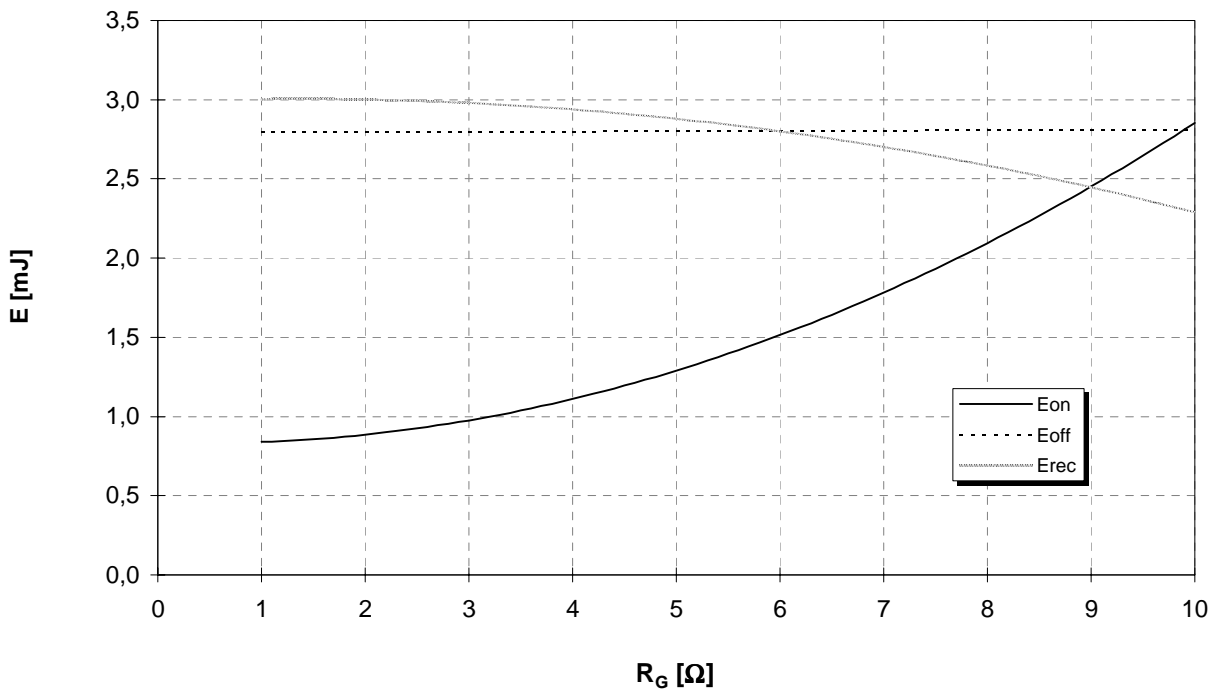
$R_{G,on} = 2,2\Omega, R_{G,off} = 2,2\Omega, V_{CC} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$

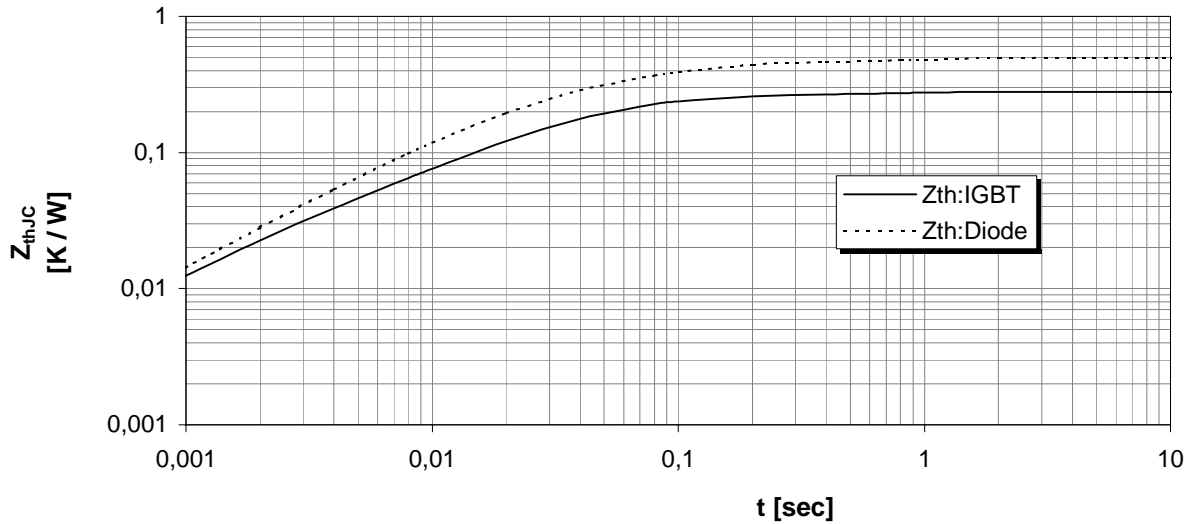
$I_C = 100A, V_{CC} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$





Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

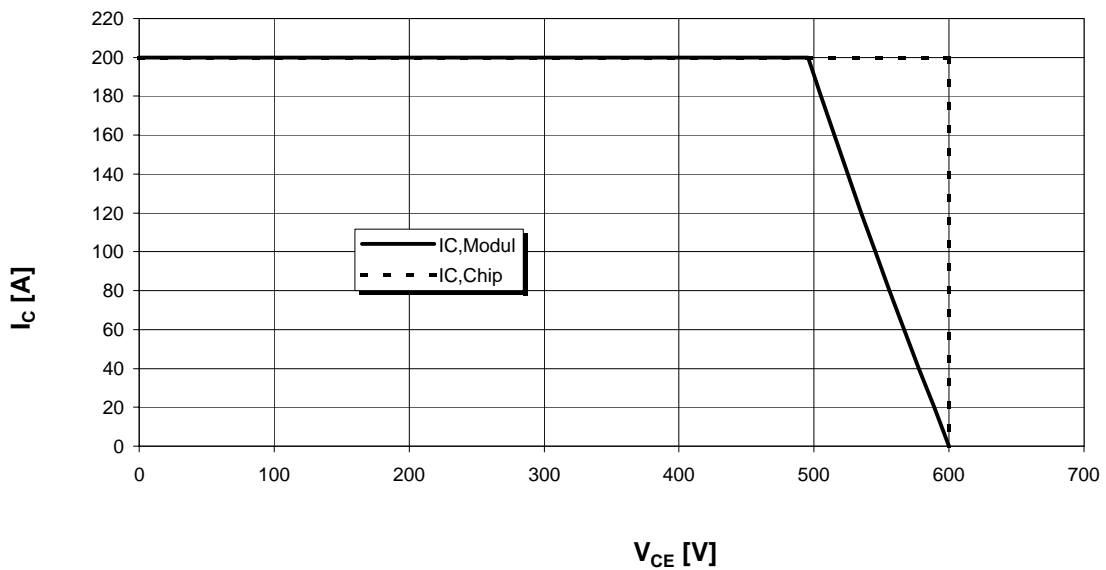
$Z_{thJC} = f(t)$

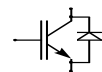


i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	11,9	146,7	98,7	22,7
τ_i [sec] : IGBT	0,0018	0,0240	0,0651	0,6626
r_i [K/kW] : Diode	176,2	169,0	106,1	48,7
τ_i [sec] : Diode	0,0487	0,0169	0,1069	0,9115

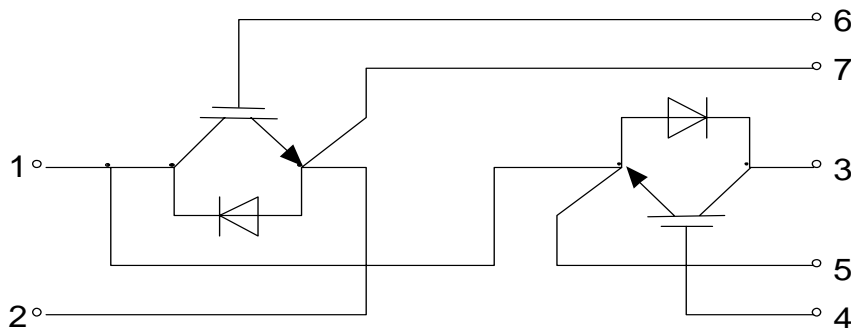
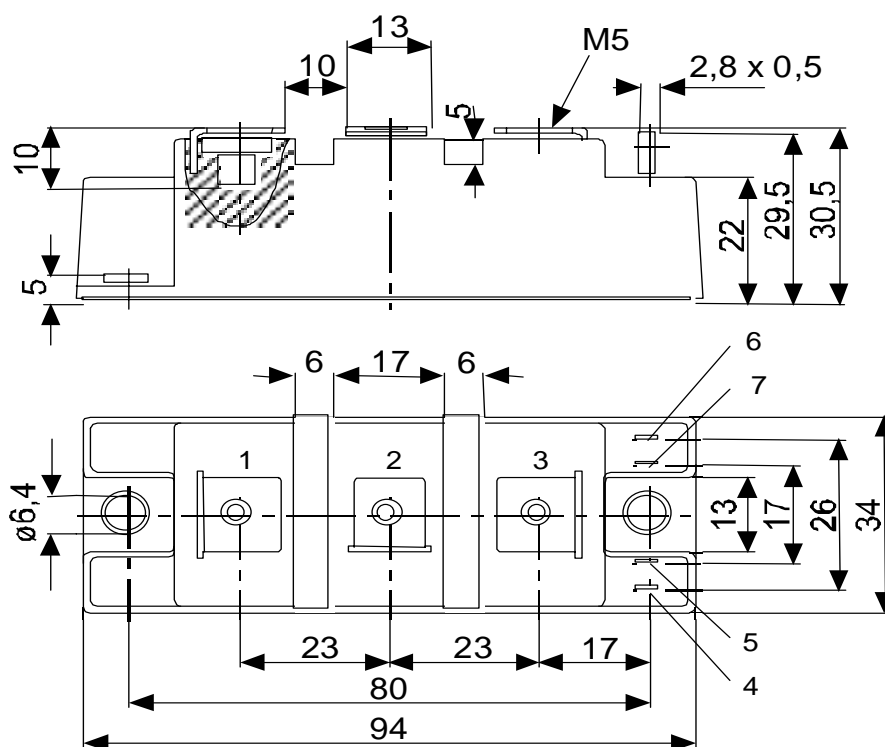
Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)
Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$V_{GE} = +15V, R_{G,off} = 2,2\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$





Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram



Terms & Conditions of Usage

Attention

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru